

Bull. 43

Границите външна среда (диелектрик) – метал и метал – скранирана област (диелектрик)  $A_d$  и на многократни вътрешни отражения  $A_M$ , т.е.  $A = A_p + A_o + A_m$ .

Забявите от потъзване в метал (магнитен или немагнитетен) нарастват с увеличаване на неговата магнитна проницаемост  $\mu$  и проводимост  $\sigma$ , а така също и с честотата  $f$  и могат да се изчислят в dB от

1

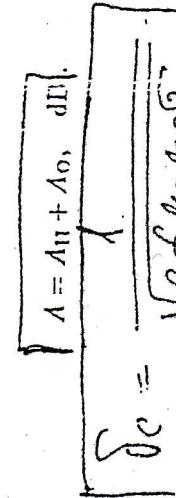
съдът  $\alpha$  е кофициент на затихване на електромагнитного поле в материалата, а  $\delta_c$  — дължочина на проникване на полето в метала (дебелина

Загубите от отражение на граничните на две среди са свързани с различните характеристични съпротивления на диелектрика (въздуха)  $Z_{el}$  и на металния скрап  $Z_{c2}$ . Като се вземе под внимание, чо  $Z_{el} > Z_{c2}$  и че за плоска електромагнитна вълна характеристичното съпротивление на въздуха  $Z_{el} = 120\pi \approx 377\Omega$ , за загубите от отражение, изразени в  $\% \text{ може да се запишат}$ .

$$(4.9) \quad A_0 \approx 20 \lg \left( \frac{Z_{c1}}{4 Z_{c2}} \right) = 20 \lg \left( \frac{94,25}{\pi f_{100} H_* (\sigma)^{0,6}} \right) = 20 \lg(94,25 \delta_c \sigma).$$

При екраниране на нисокочестотни слектромагнитни полета  $|H| > 10 \text{ dB}$  и затова многократните вътрешни отражения не влияят върху общата ефективност на скринирането, която може да се определи

(4.10)



Тази формула се използва за определяне на ефективността на скраниране във високочестотната област (над  $10^4$  Hz), където екраните работят в електромагнитен режим.

С намаляване на честотата, когато повърхностният ефект е слаб и изразен ( $\delta_0 > d$ ), затихването на енергията в метала намалява и екранниращият ефект се определя основно от отражението на електромагнитната вълна на границите диелектрик – метал и метал – диелектрик. В такъв случай изразят за ефективност на скринирането при приблизително:

$$(4.11) \quad A = 20|g| + 0.5(Z_+Z_-)d$$

Характеристичното съпротивление на средата  $Z_{c1}$  зависи от формата на скрания, която може да бъде плоска, цилиндрична или сферична (фиг. 4.36).

На фиг. 4.36 са дадени честотни зависимости на ефективността на откриване на електромагнитно поле ( $A_T$ ) с използване на немагнитен  $A_{T(H)}$  и магнитен  $A_{T(M)}$  метали; на слектрическо поле ( $A_E$ ) с немагнитен  $A_{E(H)}$  и магнитет  $A_{E(M)}$  метал и на магнитно поле ( $A_H$ ) с немагнитен  $A_{H(H)}$  и магнитет  $A_{H(M)}$  метал. Анализът показва, че електрическото поле се скрива значително по-добре от магнитното, а полето на вълната електромагнитна вълна – по-добре от магнитното, но по-леко от електрическото. Ето защо най-трудно е да се обезпечи защита от възействието на магнитни полета.

1. при екраниране на електрически полета скриниращият ефект е равен на безкрайност за  $f = 0$  и с нарастване на честотата намалява.

в електрическото поле на "маса" чрез металния скран.  
Ако за скраниране на магнитно поле се използва немагнитен скран, при действа в целия част от диапазон като електромагнитен<sup>1</sup>, т.е. на принципа на погълдане на енергията, и тъкмо то се на вихровите токове от скранирана и на отражение на енергията от скрания. Магнитният скран действа в нискочастотната област (от 0 до 3...10 kHz) като магнитостатичен, т.е. на принципа на шунтиране на магнитното поле в скрания смектка на повишаваната му магнитна пропорционалност. С повишаване на

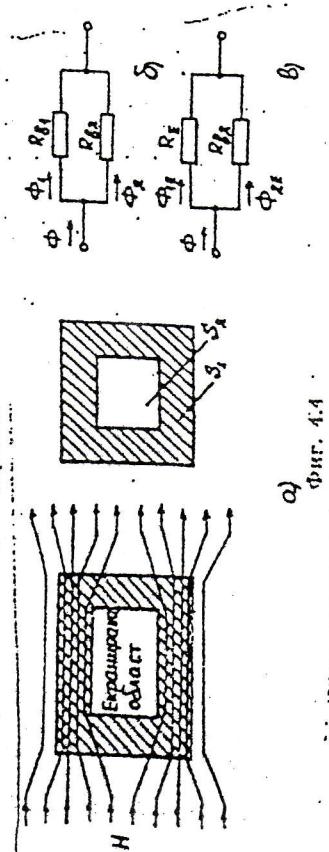
При сравнение на екрана с плоска, цилиндрична и сферична конструкция екранни по ефективност на екранната при радио други условия (шум, материал и дебелина  $d$  на екрана) се получават следните ре-

и т.н.). В областта на високите честоти коефициентите на скрапиране са по-големи от  $K_{CE}$ , килиндричен  $K_{CE}$  и сферичен  $K_{CE}$  скраи са наименуващи съмнително в следното съотношение:  $K_{CE} : K_{CE} : K_{CE} = 3 : 2 : 1$ . Едновременно за сметка на по-доброто отражение на електромагнитната вълна, плоският экран има по-висока ефективност от цилиндричния (5 dB) и сферичния (с 9,5 dB) скраи. В областта на ниските честоти

При конструиране на скрани на РСА трябва да се отчита възможността за възникване на резонансни явления в тях. Всеки електромагнитен скран представлява обемен резонатор, притежаващ няколко резонансни честоти, които се определят от размерите на скрани и компоновката на разположените в него елементи и възли. Ако честотата на смущаващото електромагнитно поле съпадне с един от собствените резонансни честоти на скрани или е близка до нея, напрегнатостта на полето в скранираната област нараства пропорционално на  $Q$ -фактора на скрани и от там ефективността на скранирането ще запише:

#### 4.3.2. Магнитни скрани

Както беше вече споменато, при скранирането на магнитни полета се използват следните основни методи: 1) магнитостатично скраниране, основано на затваряне (шунтиране) на магнитното поле в магнитния материал на скрани и 2) изтласкане на смущаващото магнитно поле от полето на вихровите токове в скрани.



Фиг. 4.4

За определяне на ефективността на магнитостатичното скраниране че бъде използван известният израз  $A = 20 \lg(H/H_E)$ , където  $H$  и  $H_E$  – а напрегнатости на магнитното поле в скранираната област преди и след въвеждане на скрани и фиг. 4.4, на които е представен магнитостатичен скран (a) и скринпелентна схема на пространството при отствие (b) и при наличие на скран (g). Магнитното съпротивление  $R_M$  на материална среда с магнитна проницаемост  $\mu_r$ , дължина на средата магнитна скоба линия в нея  $l$  и напречно сечение в направление, перпендикулярно на въздействието магнитетен поток  $S$ , може да се определи от известната формула  $R_M = l/\mu_0\mu_r S$ . Ако тази формула се използва за изразяване на магнитното съпротивление на областта от пространството с напречно сечение  $S_1$  без скран  $R_{M1}$  и с скран  $R_{M2}$  и магнитното съпротивление  $R_{M2}$  на скранирана област, чисто напречно сечение  $\epsilon$ ,  $S_2$  и се отчете паралелното включване на тези магнитни съпротивления, за ефективността на скранирането може да се запише:

$$A = 20 \lg[(\mu_r S_1 + S_2)/S_1],$$

$$\text{често } S = S_1 + S_2,$$

Ако скраният е изработен от немагнитен материал, за който  $\mu_r = 1$  (мед, месинг, алуминий), той не влияе и при ху смущаващото поле, тъй като  $R_E = R_{M1}$  и ефективността на скранирането с равна на nulla. Когато за изработка на скрани се използват феромагнитни материали с големи стойности на  $\mu_r$  (пермалой, стоман), магнитетният поток се затваря основно в стените на скрани, чисто магнитно съпротивление е значително по-малко от това на въздуха. В такъв случаи изразът (4.12) може да се опости и за ефективността на скранирането да се запише:

$$(4.13) \quad A \approx 20 \lg[(\mu_r S_1 + S_2)/S_1] = 20 \lg(1 + \mu_r S_1/S_1).$$

На базата на изложеното могат да се формулират основните изисквания към магнитостатичните скрани:

- 1) магнитната проницаемост на материалите за скрани трябва да бъде възможно най-висока, като за целта са подходящи магнитоматериални материали с високи стойности на  $\mu_r$ , например пермалоят;
- 2) за повишаване на ефективността на скранирането е необходимо да се увеличи дебелината на скрани, като при това се отчитат конструктивните ограничения по отношение на маса и размери;
- 3) психики разрези, шевове и т.н. в скрани трябва да бъдат разположени паралелно на линиите на магнитната индукция  $B$ , тъй като избросните нееднородности са разположени напречно на линиите на  $B$ , това води до увеличаване на магнитетното съпротивление на скрани и от там до намаляване на неговата ефективност;
- 4) засимяването на скрани не влияе върху ефективността на магнитостатичното скраниране.

Механизмът на втория метод за магнитно скраниране е пояснен на фиг. 4.5а. Цилиндричният метален скран е поместен в магнитно поле, така че неговата ос съвпада с направлението на магнитните силови линии. Съгласно закона за електромагнитната индукция в скрани се индуцира с.д.н., предизвиквайки противодействие на пъхрови токове, които създават вторично магнитно поле. Във вътрешността на скрани това вторично магнитно поле е противоположно, а извън скрани – съпосточно с вънуждащото поле, в резултат на което резултантното поле се оказва отслабено във вътрешността на скрани и усилено – извън него, т.е. извършва се изтласкане на полето извън скрани.

Както е известно вихровите токове в скрани се разпределят неравномерно по неговото сечение, което е свързано с явлението повърхностни или скин ефект. При увеличаване на частотата на смущаващото магнитно поле, ефективната дебелина на скрани намалява, което е причина за намаляване на магнитната проподемност на скрани. Ето защо при конструирането на по-високочестотни магнитни скрани често се предполагат немагнитни материали, тъй като те не само че осигуряват достатъчна ефективност на скранирането, но и влясят в скранираните елементи и възли по-малки загуби от магнитните материи.

да се разглеждат като Г-образни звена на филтър (фиг. 4.56). От това следва, че за определяне ефективността на екраниране на високочестотно магнитно поле трябва да се отчитат както загубите от погъщане  $A_{\text{П}}$  съгласно (4.8), така и загубите от отражение или компенсация на полето на вихровите токове в екрана  $\Delta_0 = 20 \lg [r/(1,414 \mu_r \delta_c m)]$ , т.е.:

$$(4.16) \quad A = 8,68d/\delta_c + 20 \lg [r/(1,414 \mu_r \delta_c m)],$$

където  $m$  отчита формата на екрана и има следните стойности:  $m = 1$  – за плосък;  $m = 2$  – за дилиндричен и  $m = 3$  – за сферичен екран.

При изгответванс на екрана от немагнитен метал ( $\mu_r = 1$ ) скриниращият ефект при високи честоти се определя от проводимостта на екрана и честотата на смущаващото магнитно поле. Ако екранът е изгответен от магнитен материал, смущаващото поле индуцира в него при равни други условия по-голямо е.д.н., което се обяснява с по-високата концентрация на магнитния поток. Това води до увеличаване на вихровите токове в екрана, а от там и до увеличаване на загубите от погъщане в него, което обуславя и по-добрато му ефективност. Въпреки това използването на магнитни екранни, например такива от стомана, се предполага само в случаи, когато внесените от тях загуби не оказват влияние върху работоспособността на екранираните елементи и възли.

На базата на изложеното могат да се формулират основните изисквания към екраните, действащи на принципа на изтиласкане на магнитното поле от полето на вихровите токове в екрана:

1) Дебелината на екрана трябва да се избира по-голяма от еквивалентната дължочина на проникване на полето в него. Поради малката дебелина на скин-слоя на различните материали в областта на високите честоти, при избора на дебелината на екрана определящи могат да се окажат изискванията за устойчивост на механични въздействия, на корозия, технологичност на конструкцията и др.

2) За изгответванс на високочестотни екрани се предполагат немагнитни материали (меди, алуминий, месинг). Това се обуславя както от малкото съпротивление, което оказват такива екранни на вихровите токове и от там високата им ефективност, така и от по-малките загуби, които те внасят в екранираните възли на РСА в сравнение с тези на магнитните материали.

3) Сглобките, разрезите и шевовете в скрина трябва да се разполагат по направление на вихровите токове, които текат в  $H$  по направление на перпендикуляри на направлението на смущаващото магнитно поле (фиг. 4.6a). При топа се обсърчала най-малко съпротивление за вихровите токове и от там най-висока ефективност на скриниращият ефект.

С увеличаване на честотата на смущаващото магнитно поле при  $Q_E < 1$  ефективността на екранирането е практически равна на нула, а при  $Q_E > 1$  тя се определя изцяло от качествения фактор на екрана. Ако  $Q_E$  клони към безкрайност, извън екрана се обезпечава пълна компенсация на магнитните полета, създадени от тока на скринираната верига  $I$  и тока, протичащ през екрана  $I_E$ .

С увеличаване на честотата на смущаващото магнитно поле при  $Q_E > 1$  съществува да работи в режим, при който трябва да се предвиди повърхностният ефект. В този случай екранът може да се предвиди във вид на николко последователно включени скриани с дебелина  $\Delta d$ , всеки от които образува окъсна навивка, свързана с татъчния магнитен поток на съседната навивка. Като резултат от тази големината на остатъчния взаимосързан магнитен поток в екрана намалява от слой в слой, което позволява отделните слоеве на скрина

Фиг. 4.5

За определяне на ефективността на екраниране на верига, разположена във вътрешността на немагнитен екран в областта на ниските честоти, където дебелината на скрина е много по-малка от ефективната дължочина на проникване на полето, т.е.  $d < \delta_c$ , екранът се представя във вид на окъсона навивка с индуктивност  $L_E$ , активно съпротивление  $R_E$  и взаимна индукция с скринираната верига  $M$  (фиг. 4.56). За изчисляване на  $L_E$  и  $R_E$  може да се използват формулите:

$$(4.14) \quad L_E = \mu_0 S/l; \quad R_E = 2\pi r/(\sigma dl),$$

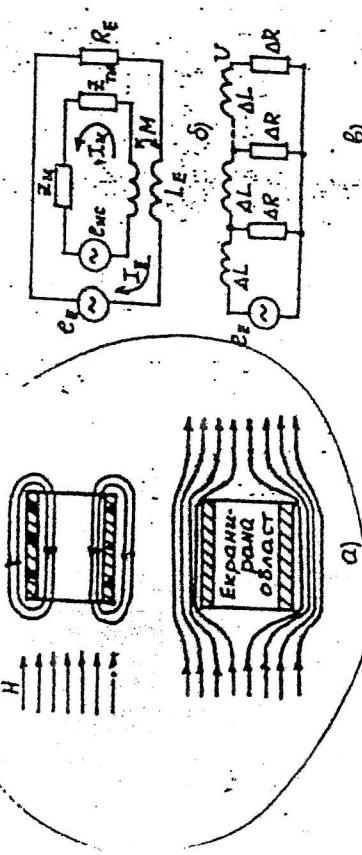
където  $g$  е радиус на екрана;  $l$  – дължина на екрана;  $S = \pi r^2$  – площ на напречното сечение на скрина; област в направление, перпендикулярно на линиите на магнитната индукция;  $d$  – дебелина на скрина.

Анализът показва, че за определяне на ефективността на магнитното екраниране в този случай може да се използва изразът:

$$(4.15) \quad |A| = 20 \lg |1 + jQ_E| = 10 \lg [1 + (0,5 \mu_0 \sigma g d)^2],$$

където  $Q_E = \omega L_E/R_E$  е качествен фактър на екрана при честота  $\omega$ . При  $Q_E < 1$  ефективността на екранирането е практически равна на нула, а при  $Q_E > 1$  тя се определя изцяло от качествения фактор на скрина. Ако  $Q_E$  клони към безкрайност, извън скриана се обезпечава пълна компенсация на магнитните полета, създадени от тока на скринираната верига  $I$  и тока, протичащ през екрана  $I_E$ .

С увеличаване на честотата на смущаващото магнитно поле при  $Q_E > 1$  съществува да работи в режим, при който трябва да се предвиди повърхностният ефект. В този случай екранът може да се предвиди във вид на николко последователно включени скриани с дебелина  $\Delta d$ , всеки от които образува окъсна навивка, свързана с татъчния магнитен поток на съседната навивка. Като резултат от тази големината на остатъчния взаимосързан магнитен поток в екрана намалява от слой в слой, което позволява отделните слоеве на скрина



Фиг. 4.6

### 4.3.3. Електростатични скрани

Принципът на електростатичното скраниране се свежда до затваряне на смущащите елементи на РСА.

Ако източникът на електростатично или квазиелектростатично поле (ИС) е поместен в метален скран, то в резултат на електрическата индукция върху вътрешната и външната повърхност на скрана се натрупват заряди с противоположни знаци (фиг. 4.7). При това в стационарен режим във вски момент от време външната повърхност на скрана се явява носител на заряд със същия знак както и източника, подложен на същото въздействие, както и при отсъствието на скрана.

При заземяване на скрана отдаленият върху външната му повърхност заряд се отвежда към заземния корпуч, където се изуляризира от заряда на другия полюс на смущаващия източник. В този случай не се предявява специални изисквания към дебелината и проводимостта на металния скран.

Основна цел на скранирането на електрическо поле е намаляване на капацитетната връзка  $C_{\text{пар}}$  между елементите на конструкцията (фиг. 4.8a).

На фиг. 4.8б е представена заместващата схема за определяне на нивото на смущенията при разделяне на източника и рецептора с скраниращ метален лист. Приетите на фигурате означения имат следното значение:  $C_{\text{пар}}$  и  $C'_{\text{пар}}$  – паразитни капацитети между източника и рецептора на смущение преди и след скраниране;  $C_{\text{ИС}}$  и  $C_{\text{РЕ}}$  – капацитети на елементите на ИС и РС спрямо металния лист E;  $C_{\text{ЕЗ}}$  – капацитет на металния лист спрямо маса (земя). Смущаващото напрежение, което поради на рецептора преди ( $U_{\text{РЕ}}$ ) и след ( $U'_{\text{РЕ}}$ ) скраниране може да се определи от:

$$\begin{aligned} U_{\text{РЕ}} &= c_{\text{ис}} C_{\text{пар}} / (C_{\text{пар}} + C_{\text{РЕ}}) \\ U'_{\text{РЕ}} &= U_{\text{РЕ}} C_{\text{РЕ}} / (C_{\text{пар}} + C_{\text{РЕ}}), \end{aligned}$$

където  $U_{\text{РЕ}}$  представлява напрежение на смущенията върху скрана, мято големина е равна на:

$$(4.19) \quad U_{\text{РЕ}} = c_{\text{ис}} C_{\text{РЕ}} / (C_{\text{ис}} + C_{\text{РЕ}}).$$

Замествайки израз (4.19) в (4.18) за  $U'_{\text{РЕ}}$  се получава:

$$(4.20) \quad U'_{\text{РЕ}} = c_{\text{ис}} C_{\text{ис}} C_{\text{РЕ}} / (C_{\text{ис}} + C_{\text{РЕ}}) / (C_{\text{РЕ}} + C_{\text{ЕЗ}}).$$

Ако  $C_{\text{ЕЗ}} \ll C_{\text{ис}}$ , напрежението на скрана ще бъде равно на с.д.н. на смущаващия източник и следователно:

$$(4.21) \quad U'_{\text{РЕ}} \approx c_{\text{ис}} C_{\text{РЕ}} / (C_{\text{РЕ}} + C_{\text{Р}}).$$

Тъй като капацитетът между скраниращия лист и рецептора на смущение е практически много по-голям от паразитния капацитет между източника и рецептора на смущение при отсъствие на скран, т.е.  $C_{\text{РЕ}} \gg C_{\text{пар}}$ , то следва че смущаващото напрежение на рецептора в разглеждания случай нараства в сравнение с това преди установяване на скрана.

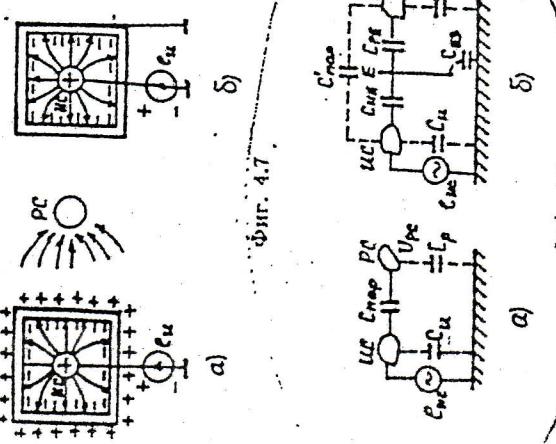
{ Очевидно, че ефективността на скранирането нараства при увеличаване на капацитета на скрана спрямо маса и става максимална при заемяване на скраниращия лист. Това се обяснява съзможността за отвеждане на индуктирани заряди на "маса" и затваряне на електрическата верига на източника на смущение. Ако в случая на заземен скран се пренебрече остатъчният паразитен капацитет  $C_{\text{пар}}$  между източника и рецептора на смущение, тогава  $U_{\text{РЕ}} = 0$ . В действителност  $C'_{\text{пар}}$ , който е много по-малък от паразитния капацитет  $C_{\text{пар}}$  между елементите преди разполагане на скрана, т.е.  $C'_{\text{пар}} \ll C_{\text{пар}}$ , обуславя появата във входа на рецептора на смущаващо напрежение:

$$(4.22), \quad U'_{\text{РЕ}} = c_{\text{ис}} C'_{\text{пар}} / (C'_{\text{пар}} + C_{\text{РЕ}} + C_{\text{Р}}) \approx c_{\text{ис}} C'_{\text{пар}} / (C_{\text{Р}} + C_{\text{РЕ}}),$$

което е значително по-малко от  $U_{\text{РЕ}}$  (вж. изръз 4.17).

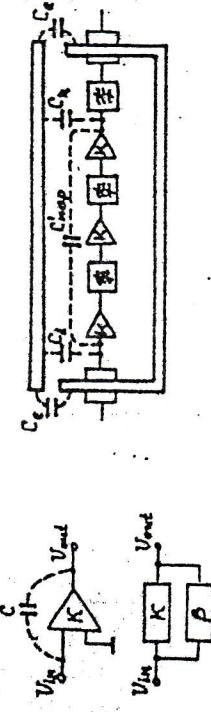
В резултат скранирацият ефект на заземения метален лист съвържа до съзряване на по-голяма част от паразитните капацитети между елементите на конструкцията към заземния корпуч на прибора.

При скраниране на смущаващото електрическо поле в рамките на едно усиливателно устройство, ефективността на скранирането зависи от неговия кофициент на усиливане  $K$  и кофициента на обратна връзка  $\beta$ , който се определя от нежеланата капацитетна обратна пръчка от изхода към входа (фиг. 4.9a). Кофициентът на усиливане  $K_{\text{оп}}$ , отчиташ наличието на паразитна капацитетна връзка между изхода и пъхала на усилателя, може да се определи от известната формула:  $K_{\text{оп}} = K / (1 - \beta K)$ . Ако  $|1 - \beta K| < 1$  обратната връзка е положителна и усиливателят може да се самопъзбуди, а при  $|1 - \beta K| > 1$  тя е отрицателна и кофициентът на усиливане на усиливателя намалява. Пропорционалността  $\beta K$  зависи от честотата, като за едини честоти се наблюдава положителна, а за други – отрицателна обратна връзка.



Фиг. 4.7

Фиг. 4.8



Фиг. 4.9

При зададена допустима стойност на кофициента на усиливане с отчитане на обратната връзка  $K_{\text{общ}}$ , допустимата стойност на коефициента на обратна връзка  $\beta_{\text{доп}}$  може да се определи от:

$$(4.23) \quad \beta_{\text{доп}} = (1 - K/K_{\text{общ}})/K.$$

За определяне на ефективността на екраниране на електрическото поле на смущенията в едно усиливателно устройство може да се използва формулата:

$$(4.24) \quad A = 20 \lg |\beta/\beta_{\text{доп}}| = 20 \lg [\beta K/(1 - K/K_{\text{общ}})].$$

Представеният начин за определяне на ефективността на екраниране може да се използва при проектиране на многостъпални усилватели (високочестотни, междинночестотни, видеосигнаватели и т.н.), като за целта се вземе предвид, че най-опасна е капацитивната връзка на по-следното и първото стъпало С пар1-п.

Обикновено в радиоелектрониката за осигуряване на защита от механични и климатични въздействия, апаратурите се разполагат в метални корпуси. Влиянието на металния капак върху работата на устройството ще бъде разгледано за случаи на изобразения на фиг. 4.9б п – стъпален междинночестотен усилвател. Както беше вече споменато, най-опасна е капацитивната връзка между последното и първото стъпало на усилвателя. Очевидно е, че въвеждането на метален капак, не присъединен към корпуса на прибора, води до увеличаване на капацитета на обратната връзка за сметка на създаването на допълнителен канал за пренасяне на смущенията, формиран от последователно включени по отношение на капака капацитети на последното  $C_n$  и първото  $C_1$  стъпала. Тъй като  $C_n C_1 / (C_n + C_1) > C'_n$ , прехвърляният от изхода към входа сигнал може да доведе до самовъзбудждане или изкиряване на честотната характеристика на усилвателя. При свързване на капака с корпуса ( $C_e = \infty$ ), двата кондензатора  $C_1$  и  $C_n$  се включват към "маса" и екраниращият ефект се обезпечава основно за сметка на значително по-малката стойност на паразитния капацитет  $C'_{\text{пар}}$  в сравнение със стойността му  $C_{\text{пар}}$  при отсъствие на капака.

Следователно за екраниране на електрическо поле първични метални елементи на конструкцията трябва да бъдат съединени с общия корпус или земята на РСА. Основно внимание при това трябва да се обръща на конструктивното изпълнение на присъединяването на скрина към корпуса на прибора. В това отношение с нисколателно използванието на дълги съединителни проводници между скрия и корпуса, особено във високочестотните обхвати, където тяхното индуктивно съпротивление илюзивава ефективността на скринирането.

В резюме основните изисквания, които се поставят към електростатичните скриани, могат да се формулират по следния начин:

1) Конструкцията на скрия трябва да бъде избрана така, че силовите линии на електрическото поле да завършват на повърхността на скрия, без да излизат зад неговите граници.

2) В областта на ниските честоти (при  $d < \delta_c$ ) ефективността на електростатичното екраниране се определя практически от качеството на електрическия контакт на скрия с корпуса на прибора и зависи слабо от материала на скрия и неговата дебелина.

3) В областта на високите честоти (при  $d > \delta_c$ ) ефективността на скрия, работещ в електромагнитен режим, се определя от неговата дебелина, проводимост и магнитна проницаемост.

#### 4.3.4. Многослойно екраниране

За постигане на висока ефективност на скринирането в широк частотен диапазон, включващи и областта на ниските честоти, се използват многослойни конструкции на скрии, които се състоят от редуваци се немагнитни (мед, алуминий, месинг) и магнитни (стомана, пермалой) слоеве. Беше изяснено, че скринираното действие на електромагнитния скриен се дължи на погълщане на енергията във вътрешността на метала и на нейното отражение на границите среда-метал и метал-скринирана област, предизвикано от различните характеристики съпротивления, които оказват дислектрениците и металите на разпространяващата се в тях електромагнитна вълна. В многослойните скриани се използва ефектът на многократно отражение на електромагнитното поле на границите между отделните метални слоесе, които се избират с различни характеристики съпротивления. Вследствие на това скриен, състоящ се от няколко тънки слоесе от различни метали, притежава високочестотната област по-голямо скриирано действие в сравнение с единороден скриен със същата дебелина.

Ефективността на екранирване на многослойни скрии зависи от използваните материали, тяхното взаимно разположение и дебелина на слоевете. На базата на проведенния анализ на този тип скрии, могат да се дадат следните препоръки за тяхното конструктивно проектиране:

1) За осигуряване на добро скрииране и минимизиране на внесените в скриираните радиослекстронни пъзли залуби, вътрешните слоесе на многослойните скрии трябва да се изработват от немагнитни метали. Най-добри резултати се получават при използване на скрии

в) от 10...20 до 1000 kHz. Медиумът и стоманен слой работят в електромагнитен режим, като с нарастващо на честотата оптическата дебелина на медния слой намалява, а на стоманения - расте, когато се обяснява с нарастващата роля на погълщащето;

г) над 1000 kHz. Използването на скрирането е нецелесъобразно, тъй като по-голяма ефективност на скрирането се обеспечава от единороден стоманен екран. Това се обяснява с преобладаващата роля на погълщащето в стоманата пред затихването на отражение на границата среда - меден слой на скриана.

Като пример на фиг. 4.10б е дадена зависимостта на ефективността на скрирането А на биметален екран от дебелината на медния  $d_m$  и на склонения  $d_e$  слоеве за честота 55 kHz и радиус на скриана 17,5 mm. От склонения  $d_e$  затихването от погълщащата картина се вижда, че с увеличаване на  $d_e$  затихването от отражение А расте, а затихването от отражение Ао - намалява. Максимална ефективност на скрирането се получава при използване на гънък меден слой ( $d_m = 18\%$ ) и дебел стоманен слой ( $d_e = 82\%$ ), като тя е по-голяма от тази на еднороден стоманен и меден скриан със скрианата дебелина съответно с 11,3% и 20,9%.

#### 4.3.5. Екраниране на проводници

За да се намали излъчването на съединителни линии, по които преминават информационните сигнали и захранващата енергия на отдалечните радиоелектронни възли, блокове и устройства, а така също индуктирането на смущения в тях, се налага те да бъдат скрианирани. Екраните могат да се изгответ като оплетка от тънки проводници, като цилиндрична спирала от плоски метални ленти или като пътна метална обивка. Използването на скрианирани проводници налага да се спазват определени изисквания при използването на скрианата обивка.

Когато скрианата обивка на проводника не е свързана към корпуса, не се постига скрииращ ефект, тъй като в скриана не могат да възникнат допълнителни токове, чисто магнитно поле би намалило полето, създадено от основния ток в проводника и липсват условия за отключане на електрическите заряди. При свързване на проводника от скриана към корпуса, който има нулев потенциал спрямо земя (фиг. 4.11a), капацитетът между скрианата обивка и корпуса се окъсва и цялото електрическо поле се концентрира в капацитета проводник - скриан, при което външно електрическо поле отсъства. За повишаване на ефективността на скриана, той трябва да се свърже към корпуса с възможно най-къс проводник. Екранираният проводник се заземява в една точка, когато неговата дължина  $l \leq 0,05\lambda_{min}$ , където  $\lambda_{min}$  е дължина на вълната на най-високочестотната съставка от спектъра на сигнала. Такова заземяне исключи приложението на електрическото поле на смущенията, но не и на масиците. За почистване и на масиците поле на смущенията, целното обратен ток  $I_{обр}$  на скрианата верига трябва да протече през скрианата обивка на

състоящи се от немагнитни и магнитни слоеве, например мед-стоманен-мед. Високата ефективност на скрирането в този случай се дължи на големията отражателна способност на медта и силното погълтане на електромагнитната енергия в стоманата.

2) Повишаване на ефективността на скрирането може да се постигне като между отделните метални слоеве се разположат диелектрични слоеве, чиято дебелина превишава значително тази на металните слоеве. Такива скриани могат да се използват само тогава, когато условията допускат известно увеличаване на техните размери и маса.

3) Многослойната конструкция на скриани се оказва особено ефективна при скриране на постоянни и нисковчастотни магнитни полета с голема напрегнатост. В случаи на однослойен магнитен скриан при високата напрегнатост на полето материалът на скриана се насища, вследствие на което неговата магнитна проницаемост  $\mu$  рязко намалява и това води до понижаване на ефективността на скрирането. За изключване влиянието на насищането при използване на двуслойен скриан е необходимо слоят, обврнат към източника на смущаващо магнитно поле, да се изготви от магнитен материал с ниска  $\mu$  и високо ниво на насищане или от немагнитен материал, а вторият слой - от материал с висока  $\mu$  и ниско ниво на насищане. В такъв случай първият слой на скриана намалява напрегнатостта на магнитното поле до стойност, не предизвикваща насищане на втория слой, който осигурява основно скрирането.

4) За избор на оптимално съотношение между дебелината на склонения слой, който осигурява скрирането, на медния слой на скрианата от типа мед-стомана, който се използва за осигуряване на най-трудно осъществимото скриране на магнитни полета, ще бъдат разгледани следните характеристики честотни области (фиг. 4.10a):

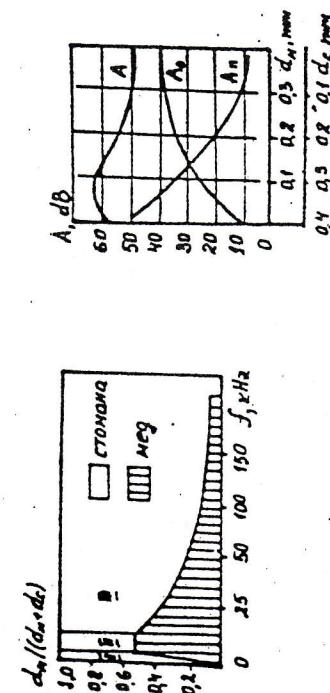
a) от 0 до 0,5 kHz. В тази честотна област скрианът работи в магнитостатичен режим за сметка на склонения слой, като скрианата действие на медния слой е много слабо изразено;

b) от 0,5 до 10 kHz. В тази честотна област медният слой преминава в електромагнитен режим на работа, докато стоманеният - продължава да работи в магнитостатичен режим. Поради това най-голяма ефективност на скрирането се получава при ранни дебелини на склоненето;

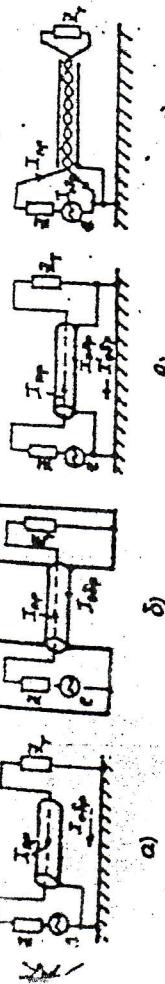
$A_e / (A_0 \cdot A_0)$

□ стомана  
■ мед

Frequency $f$ [kHz]	$A_e / (A_0 \cdot A_0)$ (Stomana)	$A_e / (A_0 \cdot A_0)$ (Med)
0.5	1.0	1.0
1.0	0.8	0.8
2.0	0.6	0.6
5.0	0.3	0.3
10.0	0.1	0.1



Фиг. 4.10



Фиг. 4.11

**ПРОВОДНИК** (фиг. 4.11б). По този начин се постига компенсация на пропътните магнитни полета, създадени от правия  $I_{\text{пр}}$  и обратния  $I_{\text{обр}}$  токове на екранирания проводник. **Пълно екраниране на магнитно поле се постига само когато екрантът е единствен проводник за обратния ток**, т.е. той не се шунтира от други проводници и корпуса. На практика екраниращата обивка на монтажни проводници с дължина по-голяма от 100 mm се заземява и в двата края (фиг. 4.11в). При това трябва да се отчита възможността за влошаване на магнитното екраниране поради появата на допълнителна верига на обратния ток, с която се нарушава компенсацията на магнитните полета на правия и обратния ток. Освен това екрантът и земята образуват кръг, на който могат да взаимействат външни магнитни полета и кондуктивни смущения, определящи се от крайното съпротивление на корпуса или шасилото.

При високи честоти, поради наличието на **взаимна индуктивност между екрана и централния проводник**, екрантът създава за обратния ток верига с по-малко съпротивление от това на заземявача верига и като резултат от това ефективността на екранирането нараства.

Висока ефективност на екранирането на електрически и магнитни полета се постига при използване на двойни екрани, а така също на усукана двойка проводници (бифиларна линия), поместена в екранираща обивка (фиг. 4.11г).

Ако корпусите на блокове  $A$  и  $B$  са свързани помежду си (фиг. 4.12а) или съществува частично окъсяване на екраниращата обивка на свързания ги проводник (фиг. 4.12б), екранирането може да се влоши съществено, поради създаване на допълнителна верига за обратния ток  $I_{\text{обр}}$ . В тъкъв случаи магнитните потоци на токовете, протичащи през проводника и прес екрани, се различават по големина, поради което ефективността на магнитното екраниране намалява. Вследствие на повърхностния ефект за честоти над 10 MHz обратният ток протича основно по вътрешната повърхност на екраниращата обивка. Колкото

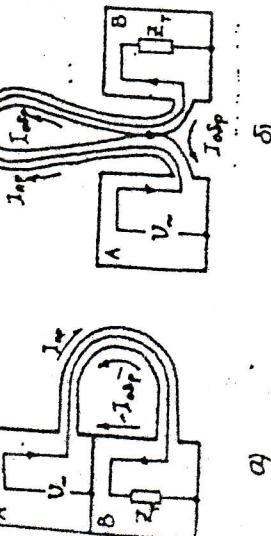
по-висока е честотътата, толкова по-малка е дълбочината на проникване на тока в екрана, т.е. толкова по-малка част от тока тече по външната повърхност на екрана, с която се намалява ефектът на парушаване на екранирането при външно късо.

Използването на екранираща обивка усложнява монтажния капацитет на проводника спрямо корпус, в резултат на която се понижава широколентовостта на "стъпалото". Например използването на екранiran проводник във веригата на видеосигналите води до спад на него-вегта пропътната характеристика в областта на високите честоти. Изходната характеристика може да се възстанови чрез **тъзвеждане на коригираща индуктивност**, включена последователно с екранирания проводник.

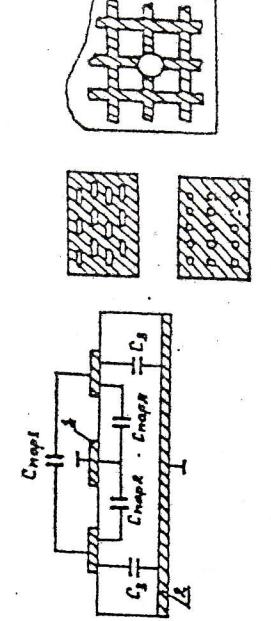
Екранираните проводници са големи, искустви при монтаж и изискват специални мерки за предотвратяване на слукачи със сигнали с други елементи на конструкцията. При това дължината на екранiranия участък трябва да бъде по-малка от четвърт дължина на дължината за най-високочестотната съставка от спектъра на предадания сигнал. Ако това условие не е спазено, проводникът се разглежда като линия с дразнителни параметри, които трябва да бъдат наредвани в двата екрана със съпротивления, равни на испилото характеристично съпротивление.

При нежелани електромагнитни връзки между монтажните проводници трябва да се екранират тези от тях, по които преминават сигнали с по-ниска честота. Например проподните на захранващата линия веригите за управление и т.н.

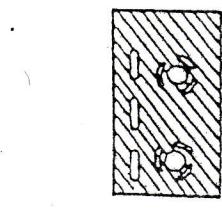
За намаляване на взаимното влияние на веригите на печатни платки, включително и многослойни, се използват печатни екрани, които представляват участъци от фолиото, свързани с корпуса или шасито на прибора. Ефективността на екранирането нараства с увеличаване на повърхността на екрана и намаляване на исковото отстояние до екранiranия участък от схемата. Пример за екраниране на печатни проводници с помощта на шина с нулев потенциал (1) и на метална екранираща плоскост (2) е даден на фиг. 4.13а. Използването на фигурата означава имат следното съдържание:  $C_{\text{напр}} = \text{паралелен клипациитет между}$



Фиг. 4.12



а)



б)  
б)  
б)  
б)